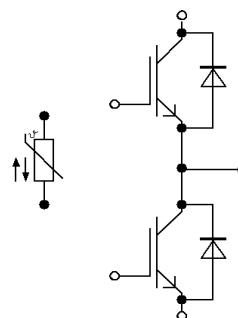


PrimePACK™3 モジュール トレンチ/フィールドストップ IGBT5とエミッターコントロール5 ダイオード内蔵とNTCサーミスタ

PrimePACK™3 module with Trench/Fieldstop IGBT5, Emitter Controlled 5 diode and NTC



$V_{CES} = 1700V$
 $I_{C\ nom} = 1500A / I_{CRM} = 3000A$

アプリケーションの可能性

- ハイパワーコンバータ
- モーター駆動
- 電鉄駆動
- 風力タービン

Potential Applications

- High power converters
- Motor drives
- Traction drives
- Wind turbines

電気的特性

- $T_{vj\ op} = 175^{\circ}C$
- 低 V_{CEsat} 飽和電圧
- 低スイッチング損失
- 拡張された動作温度 $T_{vj\ op}$
- 高い電流密度

Electrical Features

- $T_{vj\ op} = 175^{\circ}C$
- Low V_{CEsat}
- Low switching losses
- Extended operating temperature $T_{vj\ op}$
- High current density

機械的特性

- CTI(比較トラッキング指数) >400のモジュールパッケージ
- 標準ハウジング
- 長い縁面/空間距離
- 高いパワー/サーマルサイクル耐量
- 高いパワー密度

Mechanical Features

- Package with CTI > 400
- Standard housing
- High creepage and clearance distances
- High power and thermal cycling capability
- High power density

Module Label Code

Barcode Code 128



DMX - Code



Content of the Code

Content of the Code	Digit
Module Serial Number	1 - 5
Module Material Number	6 - 11
Production Order Number	12 - 19
Datecode (Production Year)	20 - 21
Datecode (Production Week)	22 - 23

IGBT- インバータ / IGBT, Inverter

最大定格 / Maximum Rated Values

コレクタ・エミッタ間電圧 Collector-emitter voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{CES}	1700	V
連続DCコレクタ電流 Continuous DC collector current	$T_C = 90^{\circ}\text{C}, T_{vj\max} = 175^{\circ}\text{C}$	I_{CDC}	1500	A
繰り返しピークコレクタ電流 Repetitive peak collector current	$t_P = 1\text{ ms}$	I_{CRM}	3000	A
ゲート・エミッタ間ピーク電圧 Gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/-20	V

電気的特性 / Characteristic Values

		min.	typ.	max.		
コレクタ・エミッタ間飽和電圧 Collector-emitter saturation voltage	$I_C = 1500\text{ A}$ $V_{GE} = 15\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$	$V_{CE\text{ sat}}$	1,75 2,10 2,30	2,20 2,65 2,90	V V V
ゲート・エミッタ間しきい値電圧 Gate threshold voltage	$I_C = 54,0\text{ mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		V_{GEth}	5,35	5,80 6,25	V
ゲート電荷量 Gate charge	$V_{GE} = -15 / 15\text{ V}, V_{CE} = 900\text{ V}$		Q_G	7,50		μC
内蔵ゲート抵抗 Internal gate resistor	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		R_{Gint}	1,0		Ω
入力容量 Input capacitance	$f = 1000\text{ kHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		C_{ies}	88,0		nF
帰還容量 Reverse transfer capacitance	$f = 1000\text{ kHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		C_{res}	2,70		nF
コレクタ・エミッタ間遮断電流 Collector-emitter cut-off current	$V_{CE} = 1700\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	I_{CES}		10	mA
ゲート・エミッタ間漏れ電流 Gate-emitter leakage current	$V_{CE} = 0\text{ V}, V_{GE} = 20\text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		I_{GES}		400	nA
ターンオン遅れ時間 (誘導負荷) Turn-on delay time, inductive load	$I_C = 1500\text{ A}, V_{CE} = 900\text{ V}$ $V_{GE} = -15 / 15\text{ V}$ $R_{Gon} = 0,51\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$	t_{don}	0,30 0,31 0,32		μs μs μs
ターンオン上昇時間 (誘導負荷) Rise time, inductive load	$I_C = 1500\text{ A}, V_{CE} = 900\text{ V}$ $V_{GE} = -15 / 15\text{ V}$ $R_{Gon} = 0,51\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$	t_r	0,15 0,16 0,16		μs μs μs
ターンオフ遅れ時間 (誘導負荷) Turn-off delay time, inductive load	$I_C = 1500\text{ A}, V_{CE} = 900\text{ V}$ $V_{GE} = -15 / 15\text{ V}$ $R_{Goff} = 0,82\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$	t_{doff}	0,66 0,74 0,80		μs μs μs
ターンオフ下降時間 (誘導負荷) Fall time, inductive load	$I_C = 1500\text{ A}, V_{CE} = 900\text{ V}$ $V_{GE} = -15 / 15\text{ V}$ $R_{Goff} = 0,82\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$	t_f	0,11 0,16 0,17		μs μs μs
ターンオンスイッチング損失 Turn-on energy loss per pulse	$I_C = 1500\text{ A}, V_{CE} = 900\text{ V}, L\sigma = 30\text{ nH}$ $di/dt = 8550\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175^{\circ}\text{C})$ $V_{GE} = -15 / 15\text{ V}, R_{Gon} = 0,51\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$	E_{on}	335 500 595		mJ mJ mJ
ターンオフスイッチング損失 Turn-off energy loss per pulse	$I_C = 1500\text{ A}, V_{CE} = 900\text{ V}, L\sigma = 30\text{ nH}$ $du/dt = 2750\text{ V}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175^{\circ}\text{C})$ $V_{GE} = -15 / 15\text{ V}, R_{Goff} = 0,82\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$	E_{off}	330 465 545		mJ mJ mJ
短絡電流 SC data	$V_{GE} \leq 15\text{ V}, V_{CC} = 1000\text{ V}$ $V_{CE\max} = V_{CES} - L_{SCE} \cdot di/dt$ $t_P \leq 10\ \mu\text{s}, T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$		I_{SC}	6000		A
ジャンクション・ケース間熱抵抗 Thermal resistance, junction to case	IGBT部 (1素子当り) / per IGBT		R_{thJC}		19,0	K/kW
ケース・ヒートシンク間熱抵抗 Thermal resistance, case to heatsink	IGBT部 (1素子当り) / per IGBT $\lambda_{Paste} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ / $\lambda_{grease} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$		R_{thCH}		15,5	K/kW
動作温度 Temperature under switching conditions			$T_{vj\text{ op}}$	-40	175	$^{\circ}\text{C}$

Diode、インバータ / Diode, Inverter

最大定格 / Maximum Rated Values

ピーク繰返し逆電圧 Repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{RRM}	1700	V
連続DC電流 Continuous DC forward current		I_F	1500	A
ピーク繰返し順電流 Repetitive peak forward current	$t_p = 1 \text{ ms}$	I_{FRM}	3000	A
電流二乗時間積 I^2t - value	$V_R = 0 \text{ V}, t_p = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $V_R = 0 \text{ V}, t_p = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$	I^2t	580 485	kA^2s kA^2s
最大損失 Maximum power dissipation	$T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$	P_{RQM}	1500	kW

電気的特性 / Characteristic Values

		min.	typ.	max.		
順電圧 Forward voltage	$I_F = 1500 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$ $I_F = 1500 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$ $I_F = 1500 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$	V_F	1,75 1,70 1,70	2,10 2,05 2,05	V V V
ピーク逆回復電流 Peak reverse recovery current	$I_F = 1500 \text{ A}, -di_F/dt = 8550 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=175^{\circ}\text{C})$ $V_R = 900 \text{ V}$ $V_{GE} = -15 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$	I_{RM}	1250 1450 1550		A A A
逆回復電荷量 Recovered charge	$I_F = 1500 \text{ A}, -di_F/dt = 8550 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=175^{\circ}\text{C})$ $V_R = 900 \text{ V}$ $V_{GE} = -15 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$	Q_r	325 550 700		μC μC μC
逆回復損失 Reverse recovery energy	$I_F = 1500 \text{ A}, -di_F/dt = 8550 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=175^{\circ}\text{C})$ $V_R = 900 \text{ V}$ $V_{GE} = -15 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$	E_{rec}	185 325 425		mJ mJ mJ
ジャンクション・ケース間熱抵抗 Thermal resistance, junction to case	/Diode (1 素子当り) / per diode		R_{thJC}		35,0	K/kW
ケース・ヒートシンク間熱抵抗 Thermal resistance, case to heatsink	/Diode (1 素子当り) / per diode $\lambda_{paste} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ / $\lambda_{grease} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$		R_{thCH}		18,5	K/kW
動作温度 Temperature under switching conditions			$T_{vj op}$	-40	175	$^{\circ}\text{C}$

NTC-サーミスタ / NTC-Thermistor

電気的特性 / Characteristic Values

		min.	typ.	max.	
定格抵抗値 Rated resistance	$T_{NTC} = 25^{\circ}\text{C}$		R_{25}	5,00	$\text{k}\Omega$
R100の偏差 Deviation of R100	$T_{NTC} = 100^{\circ}\text{C}, R_{100} = 493 \Omega$		$\Delta R/R$	-5	5 %
損失 Power dissipation	$T_{NTC} = 25^{\circ}\text{C}$		P_{25}		20,0 mW
B-定数 B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$		$B_{25/50}$	3375	K
B-定数 B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/80}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$		$B_{25/80}$	3411	K
B-定数 B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/100}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$		$B_{25/100}$	3433	K

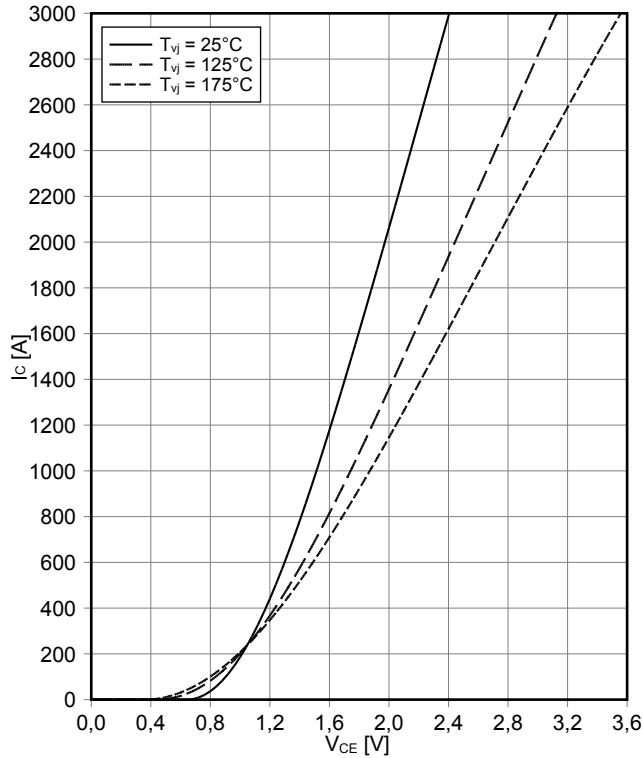
適切なアプリケーションノートによる仕様
Specification according to the valid application note.

モジュール / Module

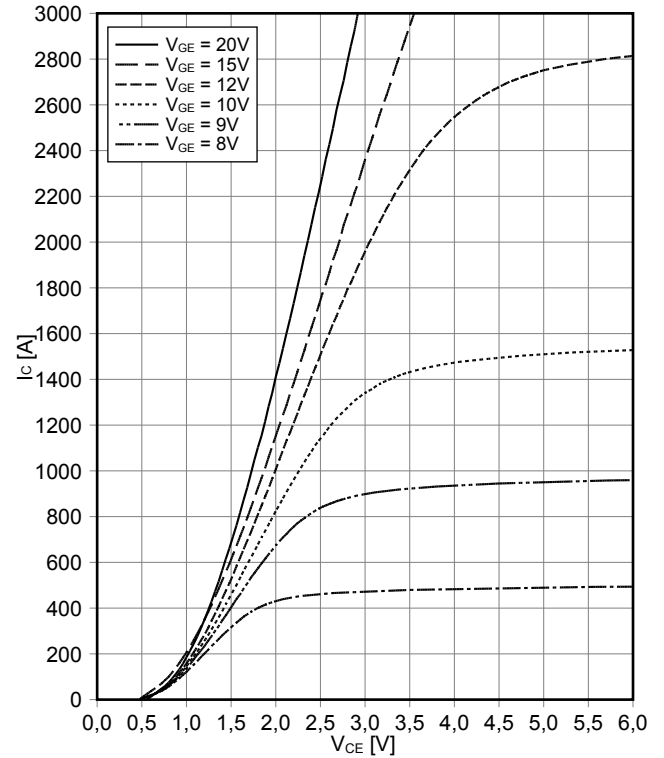
絶縁耐圧 Isolation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min.	V _{ISOL}	4,0		kV
ベースプレート材質 Material of module baseplate			Cu		
沿面距離 Creepage distance	連絡方法 - ヒートシンク / terminal to heatsink 連絡方法 - 連絡方法 / terminal to terminal		33,0 33,0		mm
空間距離 Clearance	連絡方法 - ヒートシンク / terminal to heatsink 連絡方法 - 連絡方法 / terminal to terminal		19,0 19,0		mm
相対トラッキング指数 Comperative tracking index		CTI	> 400		
min. typ. max.					
内部インダクタンス Stray inductance module		L _{sCE}		10	nH
パワーターミナル・チップ間抵抗 Module lead resistance, terminals - chip	T _c = 25°C, /スイッチ / per switch	R _{CC'+EE'} R _{AA'+CC'}		0,20 0,18	mΩ
保存温度 Storage temperature		T _{stg}	-40		150 °C
最大ベース・プレート動作温度 Maximum baseplate operation temperature		T _{BPmax}			150 °C
取り付けネジ締め付けトルク Mounting torque for modul mounting	取り付けネジ M5 適切なアプリケーションノートによるマウンティング Screw M5 - Mounting according to valid application note	M	3,00		6,00 Nm
主端子ネジ締め付けトルク Terminal connection torque	取り付けネジ M4 適切なアプリケーションノートによるマウンティング Screw M4 - Mounting according to valid application note	M	1,8	-	2,1 Nm
			8,0	-	10 Nm
質量 Weight		G		1200	g

Die thermisch abzuführende Leistung an den Lastanschlüssen muss im Systemaufbau berücksichtigt werden.
The thermal power transferred via the power terminals needs to be considered in the system design.

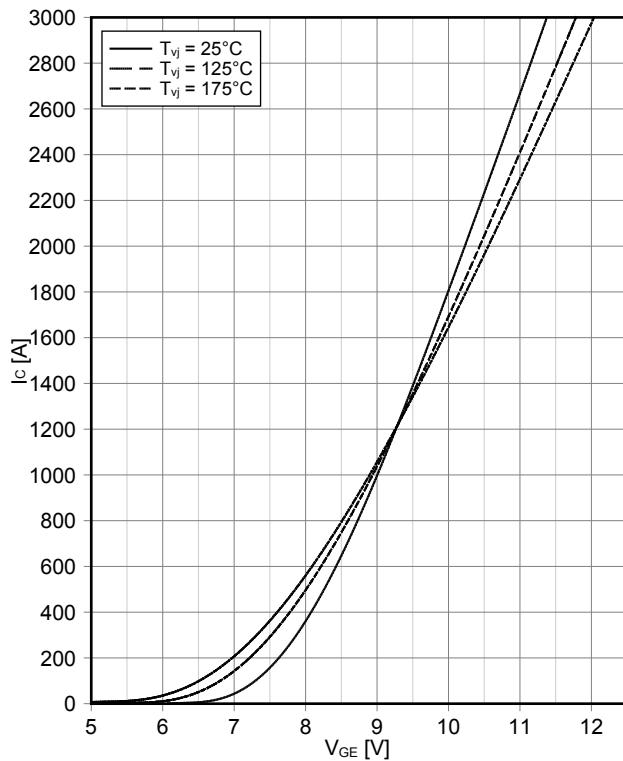
出力特性 IGBT- インバータ (Typical)
output characteristic IGBT, Inverter (typical)
 $I_C = f(V_{CE})$
 $V_{GE} = 15\text{ V}$



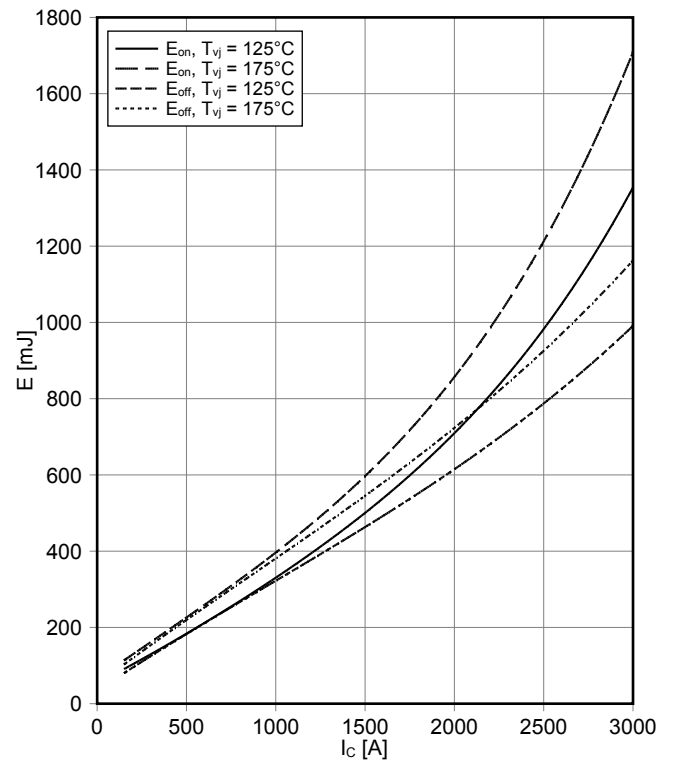
出力特性 IGBT- インバータ (Typical)
output characteristic IGBT, Inverter (typical)
 $I_C = f(V_{CE})$
 $T_{vj} = 175^\circ\text{C}$



伝達特性 IGBT- インバータ (Typical)
transfer characteristic IGBT, Inverter (typical)
 $I_C = f(V_{GE})$
 $V_{CE} = 20\text{ V}$

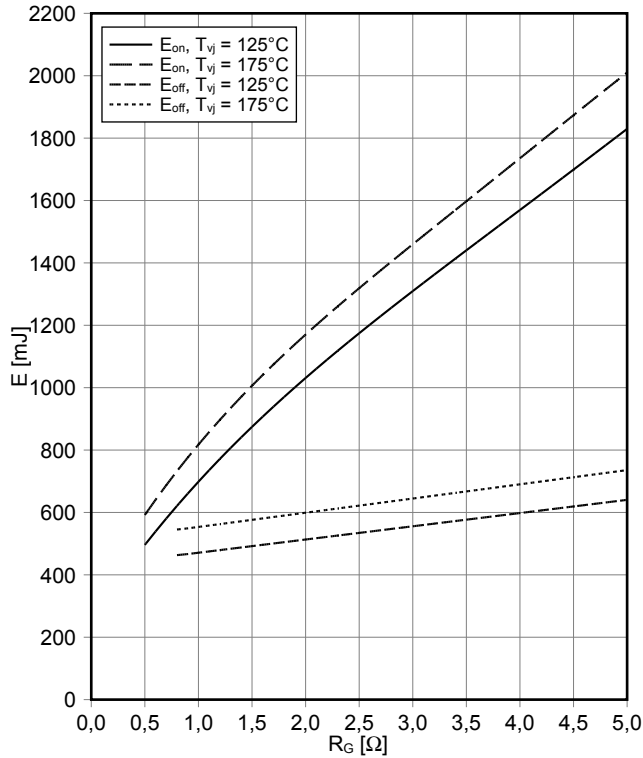


スイッチング損失 IGBT- インバータ (Typical)
switching losses IGBT, Inverter (typical)
 $E_{on} = f(I_C)$, $E_{off} = f(I_C)$
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Gon} = 0.51\ \Omega$, $R_{Goff} = 0.82\ \Omega$, $V_{CE} = 900\text{ V}$



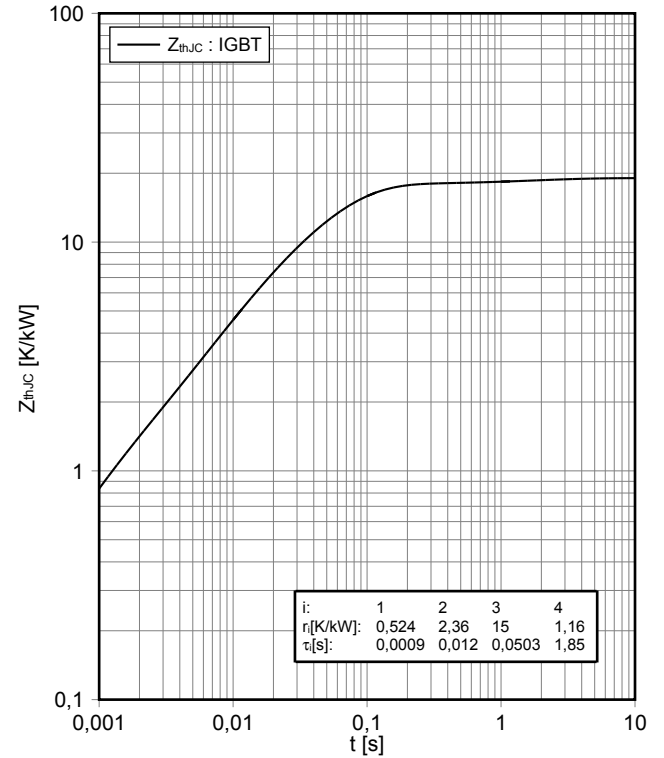
スイッチング損失 IGBT-インバータ (Typical)
switching losses IGBT, Inverter (typical)

$E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $I_C = 1500\text{ A}$, $V_{CE} = 900\text{ V}$



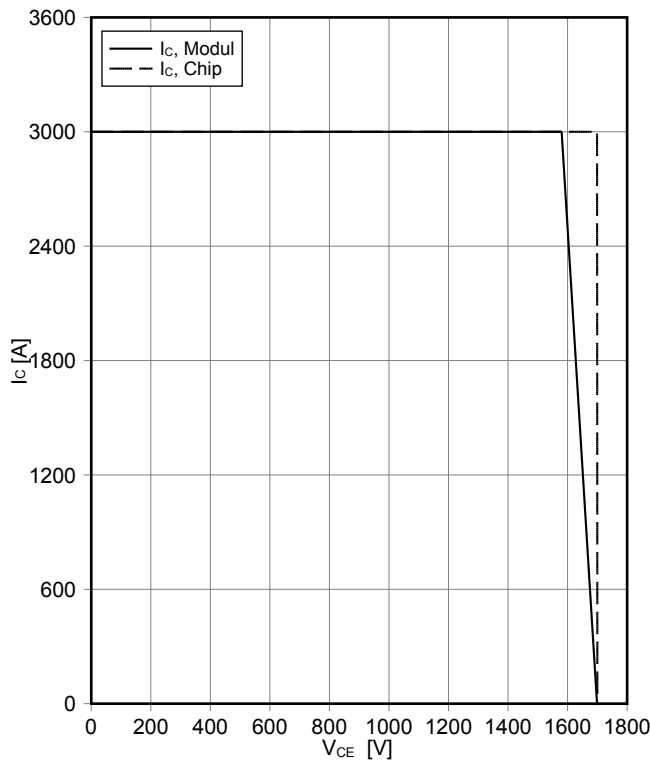
過渡熱インピーダンス IGBT-インバータ
transient thermal impedance IGBT, Inverter

$Z_{thJC} = f(t)$



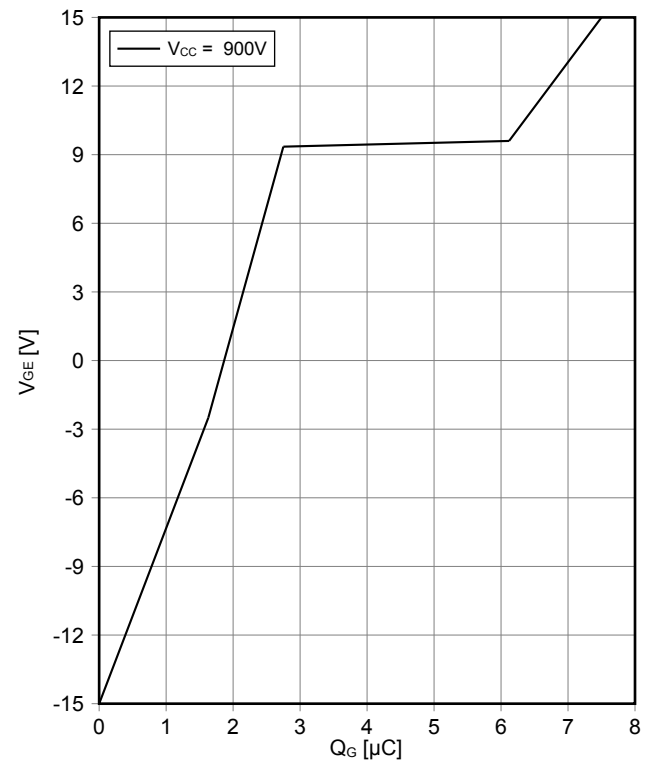
逆バイアス安全動作領域 IGBT-インバータ (RBSOA)
reverse bias safe operating area IGBT, Inverter (RBSOA)

$I_C = f(V_{CE})$
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Goff} = 0.82\ \Omega$, $T_{vj} = 175^\circ\text{C}$

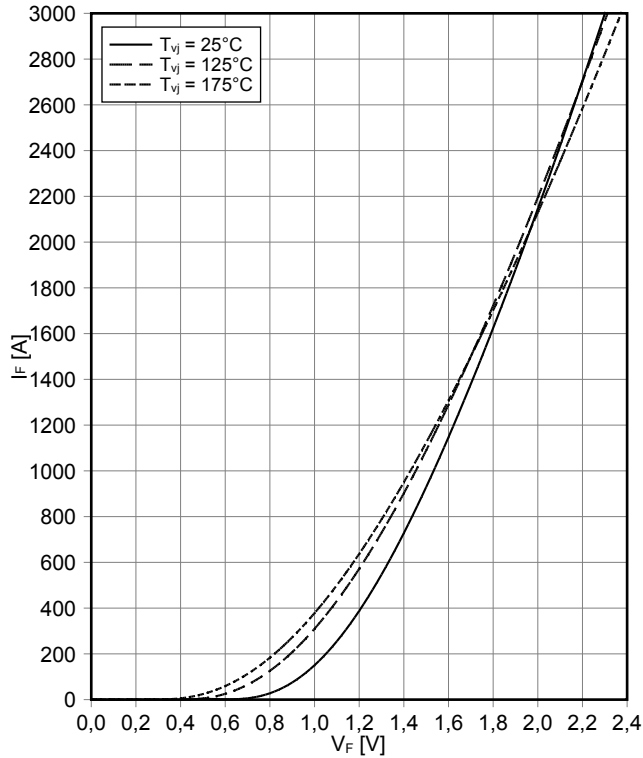


ゲート充電特性 IGBT-インバータ (典型)
gate charge characteristic IGBT, Inverter (typical)

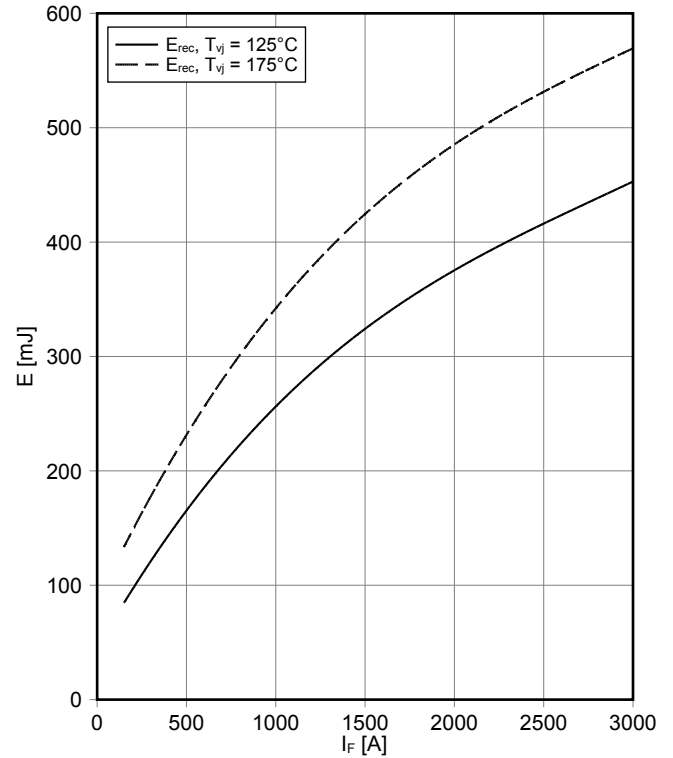
$V_{GE} = f(Q_G)$
 $I_C = 1500\text{ A}$, $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$



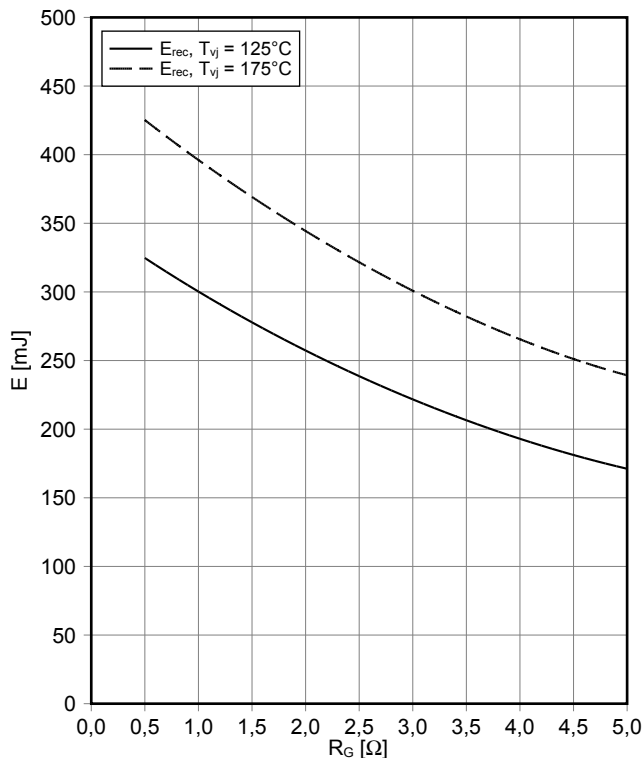
順電圧特性 Diode、インバータ (typical)
forward characteristic of Diode, Inverter (typical)
 $I_F = f(V_F)$



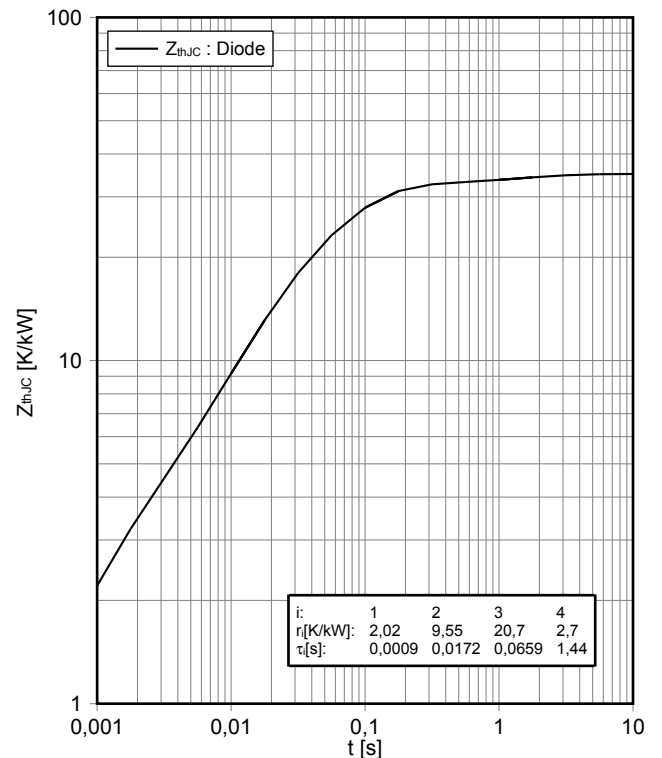
スイッチング損失 Diode、インバータ (Typical)
switching losses Diode, Inverter (typical)
 $E_{rec} = f(I_F)$
 $R_{Gon} = 0.51 \Omega, V_{CE} = 900 \text{ V}$



スイッチング損失 Diode、インバータ (Typical)
switching losses Diode, Inverter (typical)
 $E_{rec} = f(R_G)$
 $I_F = 1500 \text{ A}, V_{CE} = 900 \text{ V}$

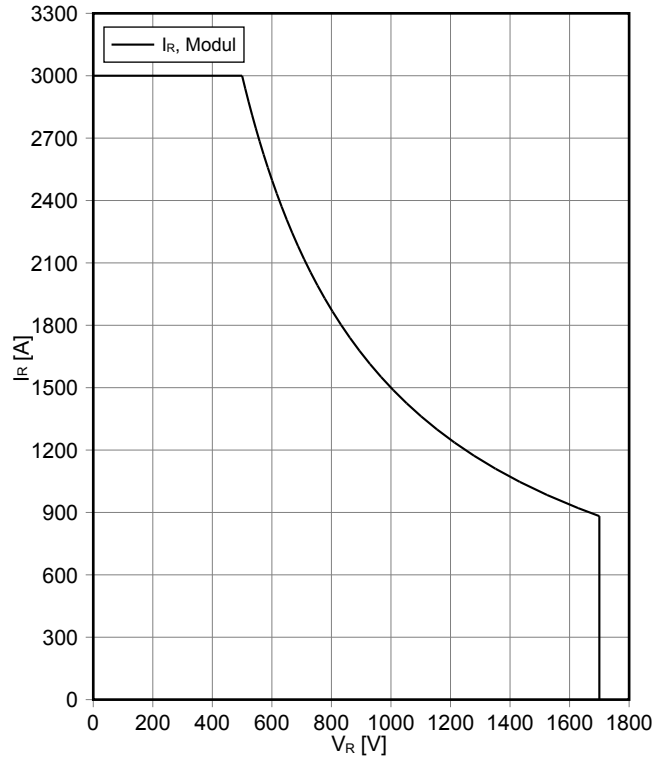


過渡熱インピーダンス Diode、インバータ
transient thermal impedance Diode, Inverter
 $Z_{thJC} = f(t)$



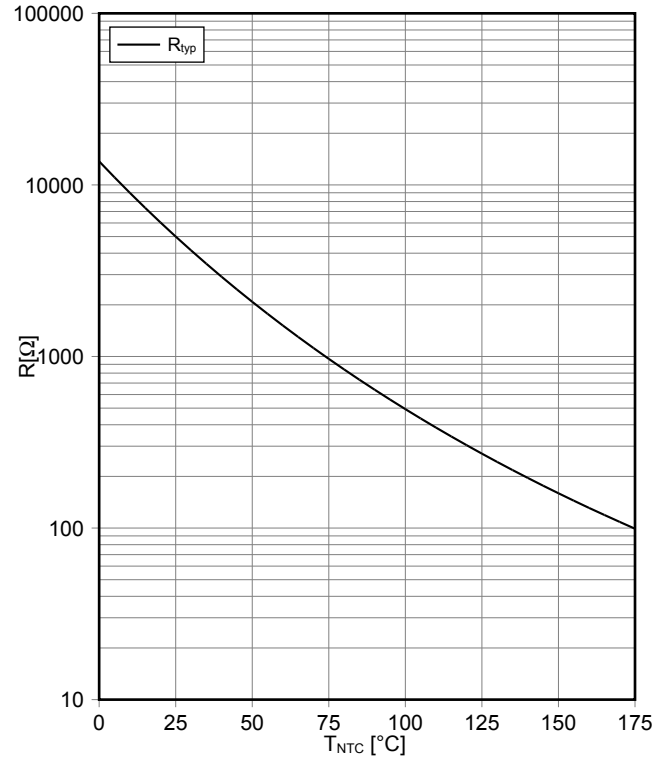
安全動作領域 Diode、インバータ (SOA)
safe operation area Diode, Inverter (SOA)

$I_R = f(V_R)$
 $T_{vj} = 175^\circ\text{C}$

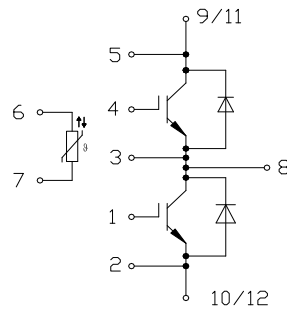


NTC-サーミスタ サーミスタの温度特性
NTC-Thermistor-temperature characteristic (typical)

$R = f(T)$



回路図 / Circuit diagram



パッケージ概要 / Package outlines

